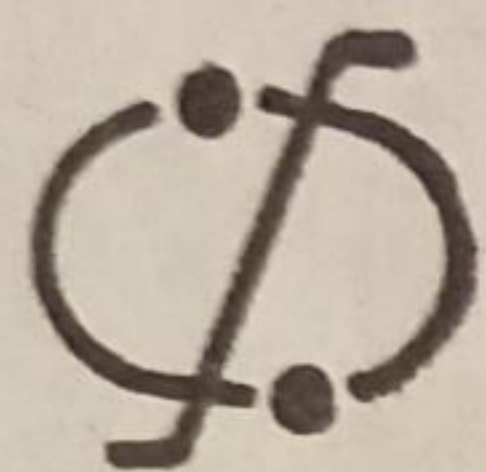




Транзисторы КТ827А, КТ827Б, КТ827В

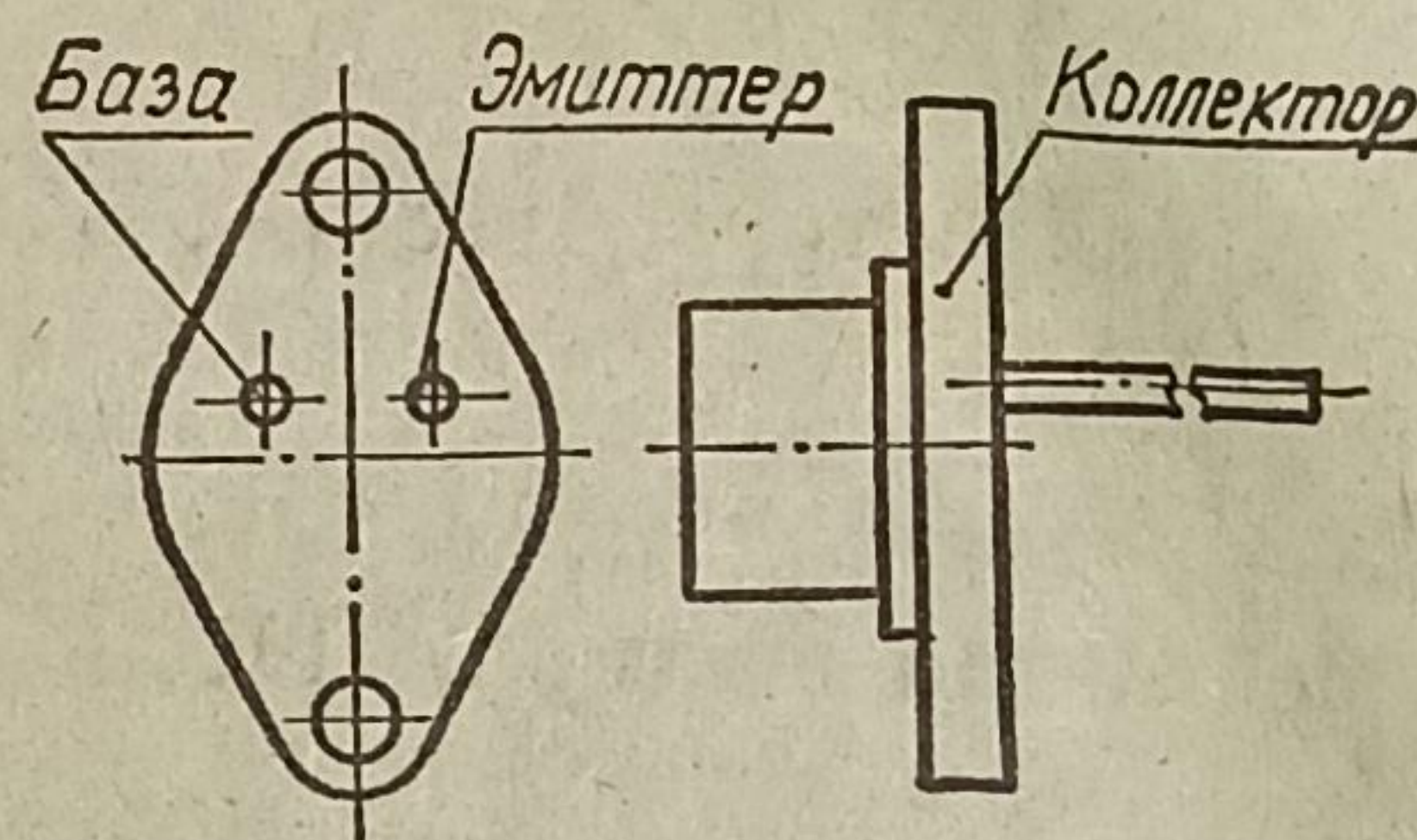
ЭТИКЕТКА



Кремниевые меза-планарные п-р-п мощные транзисторы КТ827А, КТ827Б, КТ827В в металлостеклянном корпусе КТ-9 ГОСТ 18472-88 предназначены для работы в усилителях низкой частоты, стабилизаторах тока и напряжения, импульсных усилителях мощности, повторителях, переключателях, в электронных системах управления, защиты и автоматики аппаратуры.

Климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 3.1, 5.1.

Масса транзистора не более 20 г



Основные электрические параметры при $T_{корп.} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначен.	Норма	
		не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока $U_{кэ}=3\text{ В}, I_{к}=10\text{ А}$ $U_{кэ}=3\text{ В}, I_{к}=20\text{ А}$	$h_{21э}$	750 100	18000 —
Обратный ток эмиттера, мА $U_{эб}=5\text{ В}$	$I_{эбо}$	—	2
Обратный ток коллектора, мА $U_{кб}=100\text{ В}$ для КТ827А $U_{кб}=80\text{ В}$ для КТ827Б $U_{кб}=60\text{ В}$ для КТ827В	$I_{кбо}$	— — —	0,5 0,5 0,5
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В $I_{к}=10\text{ А}, I_{б}=0,04\text{ А}$	$U_{кэ\text{ нас}}$	—	2
Напряжение насыщения база-эмиттер, В $I_{к}=20\text{ А}, I_{б}=0,20\text{ А}$	$U_{бэ\text{ нас}}$	—	4
Граничное напряжение, В $L=40\text{ мГц}, I_{к}=0,10\text{ А}$ для КТ827А для КТ827Б для КТ827В	$U_{кэо\text{ гр}}$	100 80 60	— — —
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте $f=10\text{ МГц}, I_{к}=10\text{ А}, U_{кэ}=3\text{ В},$	$(h_{21э})$	0,4	—

Содержание драгметаллов в 1000 транзисторов:

Золота — 19.090 г

Серебра —

Содержание цветных металлов в 1000 шт. транзисторов:

Наименование цветного металла или сплава	Марка	Масса, г
Медь	МО6	2900

Сведения о приемке

Транзисторы КТ827А, КТ827Б, КТ827В соответствуют техническим условиям АА0.336.356ТУ

Место для штампа ОТК

Указания по эксплуатации

Указания по применению и эксплуатации по ГОСТ 11630-84, ОСТ II 336.907.0-79 с дополнениями, изложенными ниже.

Транзисторы необходимо применять с теплоотводами. Крепление транзистора к теплоотводу должно обеспечивать надежный тепловой контакт.

Для улучшения теплового контакта необходимо наносить на нижнее основание корпуса транзистора жидкость ПМС-100 ГОСТ 13032-77 или другую теплопроводящую смазку.

При пайке выводов температура корпуса транзистора не должна превышать 100°C.

Т. 2500 З. 533-91